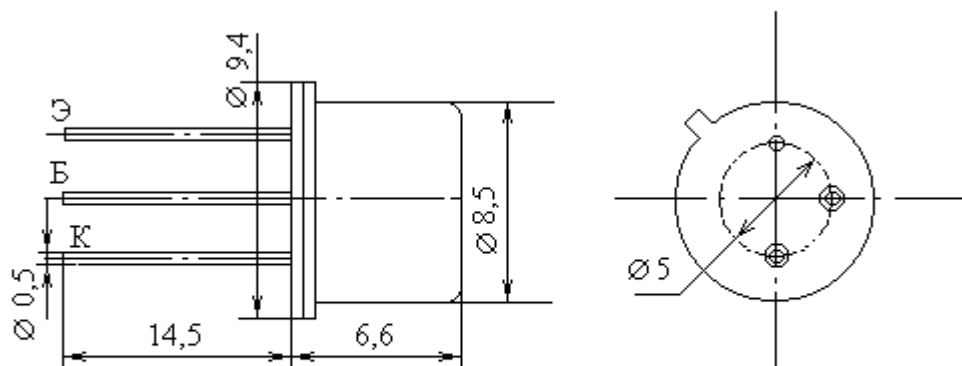


Транзисторы биполярные n-p-n большой мощности низкой и средней частоты



Название	КТ506Б
Материал	Si
$I_k \text{ max}, A$	2
$U_{кэ0} \text{ гр}(U_{кэ0,и \text{ max}})[U_{кэг \text{ max}}], B$	[600]
$U_{кбо \text{ max}}(U_{кбо,и \text{ max}}), B$	600
$U_{эбо \text{ max}}(U_{эбо,и \text{ max}}), B$	5
$P_k \text{ max}(P_k, \text{ср max})(P_k,и \text{ max}), Bт$	10
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), C$	(125)
$h_{21э}(h_{21э})[S_{21} \text{ тип}]$	30...150
при $U_{кэ}(U_{кб}), B$	(5)
$U_{кэ \text{ нас}}, B$	(0.3)
$I_{кб0}(I_{кэг})\{I_{кэ0}\}, mA$	0.6
$f_{гр}(f_{h21}), MГц$	1
$S_k, пф$	10
$S_э, пф$	40
$t_{выкл}(t_{рас})[t_{сп}], мкс$	(1.5)